

請求の範囲

- [請求項1] ウェハ主面に接触する基材シートを備え、
前記基材シートの、 $30^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ における貯蔵弾性率 E'_{30-80} の
指数近似曲線の指数係数が、 $-0.035\sim -0.070$ である、
ウェハ加工用シート。
- [請求項2] 前記基材シートの、 30°C における貯蔵弾性率 E'_{30} と、 80°C に
おける貯蔵弾性率 E'_{80} の差($E'_{30}-E'_{80}$)が、 $4.00\times 10^7\sim$
 $4.00\times 10^8\text{Pa}$ である、
請求項1に記載のウェハ加工用シート。
- [請求項3] 前記基材シートの、 80°C における貯蔵弾性率 E'_{80} が、 5.00
 $\times 10^5\sim 1.00\times 10^7\text{Pa}$ である、
請求項1又は2に記載のウェハ加工用シート。
- [請求項4] 前記基材シートの、 $80\sim 110^{\circ}\text{C}$ の温度範囲における貯蔵弾性率
 E'_{80-110} が、 $1.00\times 10^6\sim 1.00\times 10^7\text{Pa}$ である、
請求項1～3のいずれか一項に記載のウェハ加工用シート。
- [請求項5] 前記基材シートの、 80°C における損失弾性率 E''_{80} が、 1.50
 $\times 10^4\sim 1.50\times 10^6\text{Pa}$ である、
請求項1～4のいずれか一項に記載のウェハ加工用シート。
- [請求項6] 前記基材シートの、 30°C における損失弾性率 E''_{30} が、 1.00
 $\times 10^6\sim 1.50\times 10^8\text{Pa}$ である、
請求項1～5のいずれか一項に記載のウェハ加工用シート。
- [請求項7] 前記基材シートの融点が、 70°C 以上である、
請求項1～6のいずれか一項に記載のウェハ加工用シート。
- [請求項8] 加温された、請求項1～7のいずれか一項に記載のウェハ加工用シ
ートの基材シートの表面と、ウェハの主面と、を貼り合わせる貼合工
程と、
前記基材シートと前記ウェハとを貼り合わせた状態で、前記ウェハ
を加工する加工工程と、を有する、

ウェハの加工方法。

[請求項9] 前記加工工程において、前記基材シートが貼り合わされていない前記ウェハの主面をグラインドして、薄化ウェハを得る、
請求項8に記載のウェハの加工方法。

[請求項10] 前記加工工程において、前記ウェハをダイシングして、半導体チップを得る、
請求項8に記載のウェハの加工方法。